

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2023-28725  
(P2023-28725A)

(43)公開日

令和5年3月3日(2023. 3. 3)

(51)Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
H O 1 L 21/336 (2006. 01)	H O 1 L 29/78 3 0 1 X	5 F 0 3 8
H O 1 L 29/66 (2006. 01)	H O 1 L 29/66 T	5 F 0 4 8
H O 1 L 29/786 (2006. 01)	H O 1 L 29/78 3 0 1 J	5 F 1 1 0
H O 1 L 21/8234 (2006. 01)	H O 1 L 29/78 3 0 1 G	5 F 1 4 0
H O 1 L 27/088 (2006. 01)	H O 1 L 29/78 6 1 7 N	
審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 16 頁) 最終頁に続く		

(21)出願番号 特願2021-134599(P2021-134599)  
(22)出願日 令和3年8月20日(2021. 8. 20)

(出願人による申告) 令和2年度、国立研究開発法人科学技術振興機構、戦略的創造研究推進事業「S S F E T、メタマテアンテナの開発とR F E Hシステムフロント・エンドの設計」委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願

(71)出願人 593165487  
学校法人金沢工業大学  
石川県野々市市扇が丘7番1号  
(74)代理人 100105924  
弁理士 森下 賢樹  
(72)発明者 井田 次郎  
石川県野々市市扇が丘7番1号 学校法人  
金沢工業大学内  
(72)発明者 森 貴之  
石川県野々市市扇が丘7番1号 学校法人  
金沢工業大学内  
Fターム(参考) 5F038 CA02 CA07 EZ02 EZ06  
5F048 AA08 AC01 BA16 BB02 BC02  
BF16 BF18

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 マルチフィンガー半導体構造

(57)【要約】

【課題】  $I_d - V_g$ 特性に乱れを生じることなく、PNBT SOI-FET同士を並列接続する。

【解決手段】 マルチフィンガー半導体構造5は、ソースと、ドレインと、第1ゲート20と、ボディコンタクト部24と、を含むMOSFETを備え、ボディコンタクト部24とソースおよびドレインとの間に、ボディコンタクト部24の不純物の型と反対の型の半導体層26を備えた複数の単位半導体構造1A、1B、1C、...を並列にマルチフィンガー接続したマルチフィンガー半導体構造であって、ボディコンタクト部24および半導体層26は、一体化されていることを特徴とする。

【選択図】 図9

